

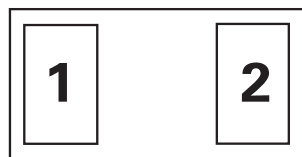
SP1008 Series 6pF 15kV Bidirectional Discrete TVS



Description

The SP1008 includes back-to-back TVS diodes fabricated in a proprietary silicon avalanche technology to provide protection for electronic equipment that may experience destructive electrostatic discharges (ESD). These robust diodes can safely absorb repetitive ESD strikes above the maximum level specified in the IEC61000-4-2 international standard ($\pm 15\text{kV}$ contact discharge) without performance degradation. The back-to-back configuration provides symmetrical ESD protection for data lines when AC signals are present.

Pinout



Note: Drawing not to scale

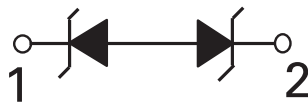
Features

- ESD, IEC61000-4-2, $\pm 15\text{kV}$ contact, $\pm 15\text{kV}$ air
- EFT, IEC61000-4-4, 40A (5/50ns)
- Lightning, IEC61000-4-5, 2.5A ($t_p=8/20\mu\text{s}$)
- Low capacitance of 6pF (@ $V_R=5\text{V}$)
- Low leakage current of 0.1 μA at 5V
- Space efficient 0201 footprint

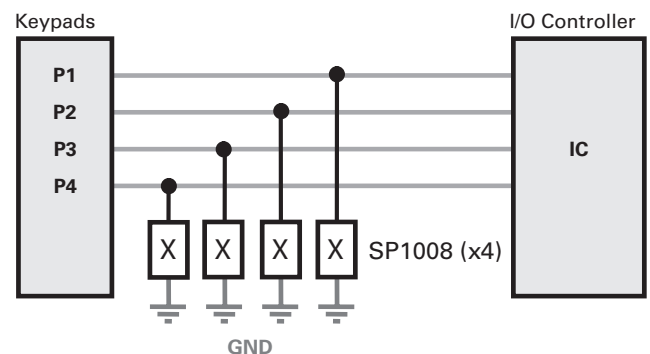
Applications

- Mobile Phones
- MP3/PMP
- Portable Medical
- Camcorders
- Smart Phones
- eReaders/eBooks
- Tablets
- Digital Cameras

Functional Block Diagram



Application Example



Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Value	Units
I_{PP}	Peak Current ($t_p=8/20\mu s$)	2.5	A
T_{OP}	Operating Temperature	-40 to 85	°C
T_{STOR}	Storage Temperature	-65 to 150	°C

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

Thermal Information

Parameter	Rating	Units
Storage Temperature Range	-65 to 150	°C
Maximum Junction Temperature	150	°C
Maximum Lead Temperature (Soldering 20-40s)	260	°C

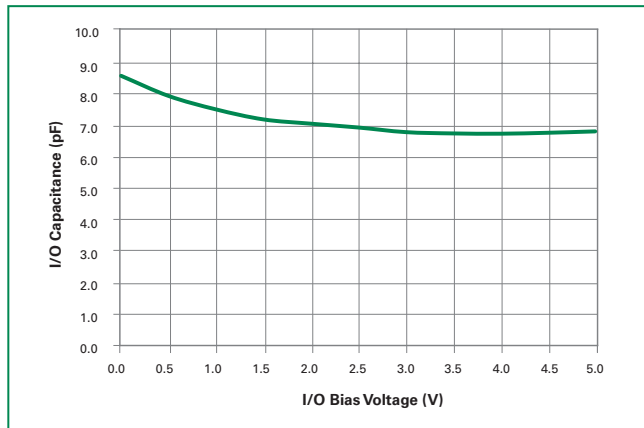
Electrical Characteristics ($T_{OP}=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Reverse Standoff Voltage	V_{RWM}				6.0	V
Breakdown Voltage	V_{BR}	$I_R=1mA$		7.0	8.5	V
Leakage Current	I_{LEAK}	$V_R=5V$ with 1 pin at GND		0.1		μA
Clamp Voltage ¹	V_C	$I_{PP}=1A$, $t_p=8/20\mu s$, Fwd		10.7		V
		$I_{PP}=2A$, $t_p=8/20\mu s$, Fwd		12.0		V
Dynamic Resistance	R_{DYN}	$(V_{C2} - V_{C1}) / (I_{PP2} - I_{PP1})$		1.3		Ω
ESD Withstand Voltage ¹	V_{ESD}	IEC61000-4-2 (Contact Discharge)	± 15			kV
		IEC61000-4-2 (Air Discharge)	± 15			kV
Diode Capacitance ¹	C_D	Reverse Bias=0V		9		pF
		Reverse Bias=5.0V		6	9	pF

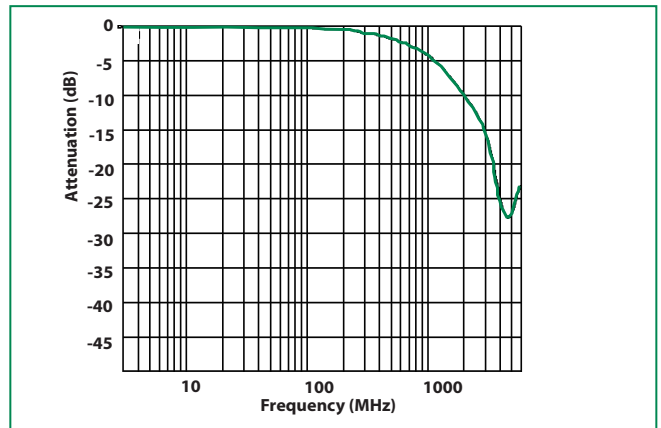
Note:

¹Parameter is guaranteed by design and/or device characterization.

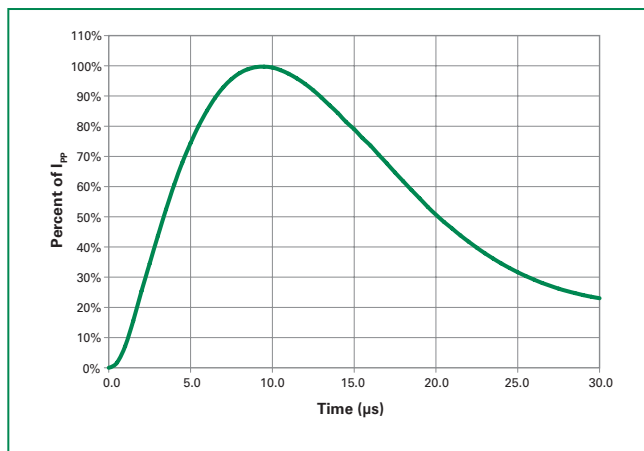
Capacitance vs. Reverse Bias



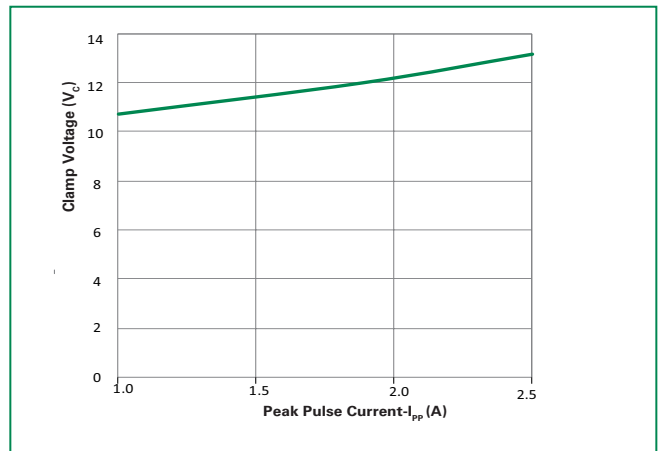
Insertion Loss (S21) I/O to GND



Pulse Waveform

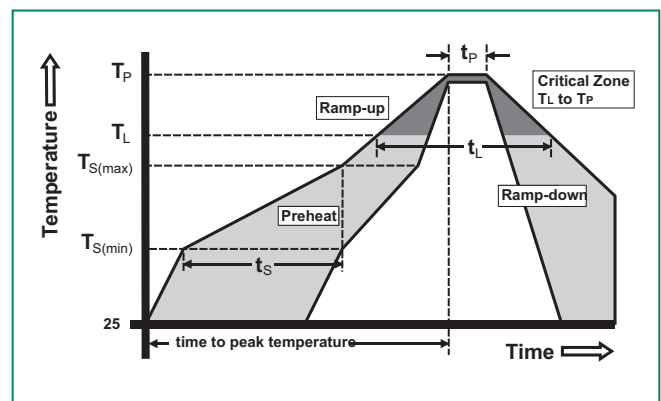


Clamping Voltage vs. I_{pp}

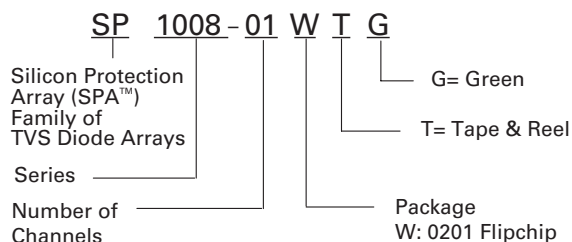


Soldering Parameters

Reflow Condition		Pb – Free assembly
Pre Heat	- Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	- Temperature Max ($T_{s(max)}$)	200°C
	- Time (min to max) (t_s)	60 – 180 secs
Average ramp up rate (Liquidus) Temp (T_L) to peak		3°C/second max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3°C/second max
Reflow	- Temperature (T_L) (Liquidus)	217°C
	- Temperature (t_L)	60 – 150 seconds
Peak Temperature (T_p)		260 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t_p)		20 – 40 seconds
Ramp-down Rate		6°C/second max
Time 25°C to peak Temperature (T_p)		8 minutes Max.
Do not exceed		260°C



Part Numbering System



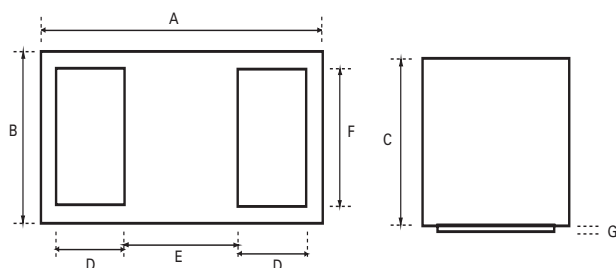
Ordering Information

Part Number	Package	Marking	Min. Order Qty.
SP1008-01WTG	0201 Flipchip	X	10000

Part Marking System

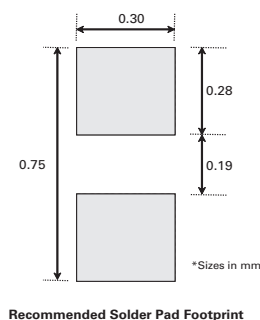
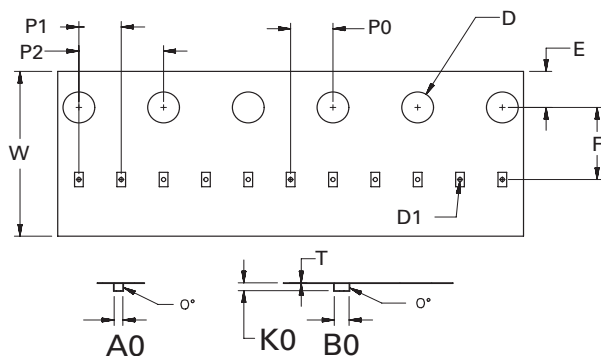
X

Package Dimensions — 0201 Flip Chip



Symbol	0201 Flipchip					
	Millimeters			Inches		
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
A	0.595	0.620	0.645	0.0234	0.0244	0.0254
B	0.295	0.320	0.345	0.0116	0.0126	0.0136
C	0.245	0.275	0.305	0.0096	0.0108	0.0120
D	0.145	0.150	0.155	0.0057	0.0059	0.0061
E	0.245	0.250	0.255	0.0096	0.0098	0.0100
F	0.245	0.250	0.255	0.0096	0.0098	0.0100
G	0.005	0.010	0.015	0.0002	0.0004	0.0006

Embossed Carrier Tape & Reel Specification — 0201 Flipchip



Symbol	Millimeters
A0	0.41+/-0.03
B0	0.70+/-0.03
D	ø 1.50 + 0.10
D1	ø 0.20 +/- 0.05
E	1.75+/-0.10
F	3.50+/-0.05
K0	0.38+/-0.03
P0	2.00+/-0.05
P1	2.00+/-0.05
P2	4.00+/-0.10
W	8.00 + 0.30 -0.10
T	0.23+/-0.02

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9